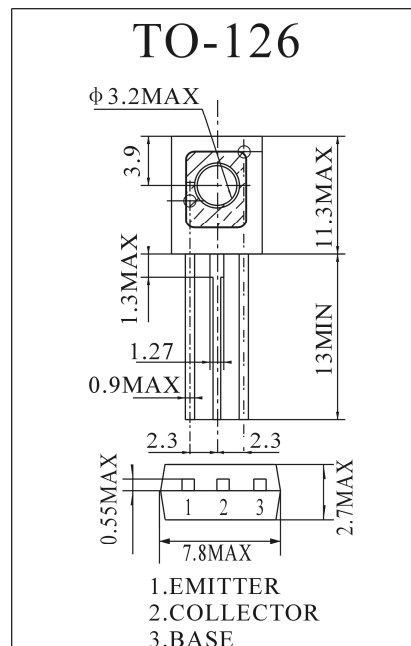




—PNP silicon—

■ ■ 绝对最大额定值 (Ta=25℃)

项 目	符 号	额定值	单 位
集电极—基极电压	V_{CBO}	-120	V
集电极—发射极电压	V_{CEO}	-120	V
发射极—基极电压	V_{EBO}	-5	V
集电极电流	I_C	-1	A
集电极耗散功率	P_C	1	W
集电极耗散功率($T_C=25^{\circ}\text{C}$)	P_C	8	W
结 温	T_J	150	$^{\circ}\text{C}$
存储温度	T_{stg}	-55~150	$^{\circ}\text{C}$



■ ■ 电参数 (Ta=25℃)

项 目	符 号	最小值	典型值	最大值	单位	测 试 条 件
直流电流增益	h_{FE1}	60		320		$V_{CE} = -5V, I_C = -50mA$
	h_{FE2}	20				$V_{CE} = -5V, I_C = -500mA$
集电极-基极截止电流	I_{CBO}			-1	μA	$V_{CB} = -50V, I_E = 0$
发射极-基极截止电流	I_{EBO}			-1	μA	$V_{EB} = -4V, I_C = 0$
集电极-基极击穿电压	BV_{CBO}	-120			V	$I_C = -0.01mA, I_E = 0$
集电极-发射极击穿电压	BV_{CEO}	-120			V	$I_C = -1mA, I_B = 0$
发射极-基极击穿电压	BV_{EBO}	-5			V	$I_E = -0.01mA, I_C = 0$
集电极-发射极饱和压降	$V_{CE(sat)}$		-0.15	-0.4	V	$I_C = -500mA, I_B = -50mA$
基极-发射极饱和压降	$V_{BE(sat)}$		-0.85	-1.2	V	$I_C = -500mA, I_B = -50mA$
电流增益-带宽乘积	f_T	50	110		MHz	$I_C = -50mA, V_{CE} = -10V$
共基极输出电容	C_{ob}		30		pF	$V_{CB} = -10V, I_E = 0, f = 1MHz$
下降时间	t_f		80		ns	$V_{CE} = -12V, P_W = 20 \mu s$ $I_C = 10I_{B1} = -10I_{B2} = -500 mA$
关断时间	t_{off}		100		ns	
存储时间	t_{stg}		600		ns	

■ ■ h_{FE} 分档及其标志

分档	D	E	F
h_{FE1}	60~120	100~200	160~320